

S60JC10V**100V 60A****特長**

- 低VF
- 低ノイズ
- 高耐圧
- 高速スイッチング
- 低IR

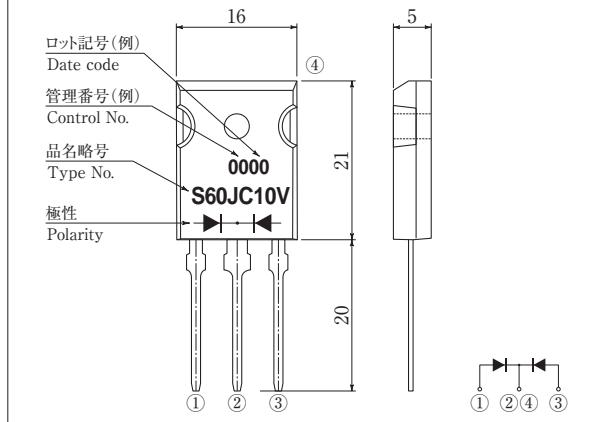
Feature

- Low VF
- Low Noise
- High Voltage
- High Recovery Speed
- Low IR

■外観図 OUTLINE

Package : MTO-3PV

Unit:mm



外形図については新元電工 Web サイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

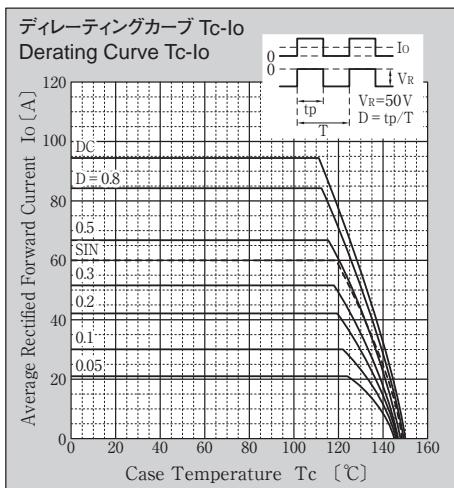
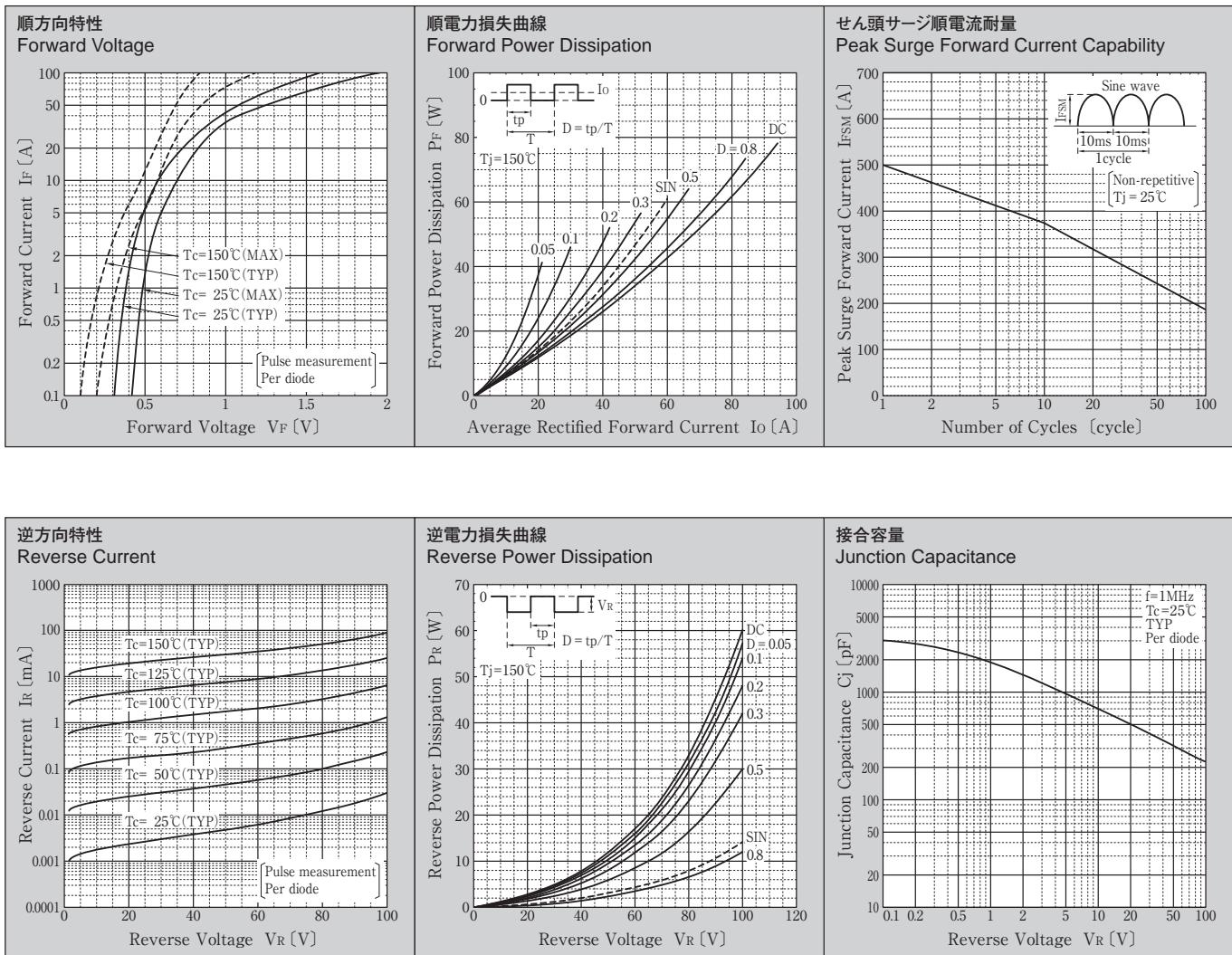
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55 ~ 150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		100	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 I _O /2, T _c = 118°C 50Hz sine wave, Resistance load, Rating for each diode I _O /2, T _c = 118°C	60	A
せん頭サーボジ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C	500	A
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.5N·m) (Recommended torque: 0.5N·m)	0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 30 A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.95	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = 100 V, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.2	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10 V, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 695	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 0.5	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.